

半導体結晶表面改質装置 CSR-2400



本装置はAr中で2400℃まで加熱でき、半導体結晶表面改質後、装備のRHEED電子銃にて表面構造をその場観察することを目的としています。またガス種を付属することでSiC液相エピタキシャルや高温熱処理炉としても使用できます。

半導体結晶表面改質装置CSR-2400仕様

- 到達圧力 $\times 10^{-4}$ Pa以下※常温・無負荷時
- 加熱温度 max2400℃
- 均熱帯 $\phi 50\text{mm} \times 50\text{mmH}$
- 圧力制御範囲 常圧～13.3Pa
- 加熱方法 高周波誘導加熱
高周波電源30KHz30KW
整合器
- 真空排気系 ドライポンプ:500L/min
ターボ分子ポンプ:550L/sec
- 真空計 サーマカップル真空計/電離真空計/バラトロン真空計
- 温度制御 放射温度計(500～3500℃)
プログラム温度調節計
- ガス制御 APCコントローラ/排気スロットルバルブ
Arマスフローコントローラ
- 試料昇降機構 上下昇降・回転機能
- RHEED VE-052S
蛍光スクリーン/防着シャッター/CCDカメラ
- 冷却水ユニット
- 独立操作盤